

利用一种简单方法制备的高质量的p型ZnO薄膜及其性质

毛飞燕^①, 邓宏^{①*}, 戴丽萍^①, 陈金菊^①, 袁兆林^②, 李燕^①

① 电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室, 成都 610054;

② 电子科技大学物理电子学院, 成都 610054

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(0\)](#)[相关文章 \(15\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)

版权所有 © 《中国科学》杂志社

地址: 北京市东黄城根北街16号, 《科学通报》编辑部, 100717

电话: 010-64036120 E-mail: csb@scichina.org

网络系统维护电话: 010-64034113 E-mail: sys@scichina.org